

Тематический указатель статей, опубликованных в 2019 году

Фундаментальные исследования

Горбачев А.А., Журавлёв М.Н. Электронные свойства ветвящихся молекулярных структур. Обзор. Т. 24, № 5, с. 439–458.

Малышев И.В., Филь К.А., Гончарова О.А. Определение компонент объемной проводимости полупроводников типа $A^{III}B^V$ в сильных постоянных электрических полях и при гармоническом воздействии. Т. 24, № 1, с. 7–15.

Сибатов Р.Т., Морозова Е.В., Костишко Б.М., Светухин В.В., Кицюк Е.П., Павлов А.А. Модель аномальной диффузии для описания импеданса литий-ионного аккумулятора. Т. 24, № 4, с. 331–341.

Материалы электроники

Белогорохов И.А., Белогорохова Л.И. Исследование композиционных материалов на основе полистирола и сахарозы методом ИК-спектроскопии. Т. 24, № 1, с. 16–21.

Вигдорович Е.Н. Формирование низкоомных слоев p -типа в гетероструктурах $Ga_{1-x}Al_xN/GaN$. Т. 24, № 2, с. 118–128.

Гаджиев Т.М., Алиев М.А., Асваров А.Ш., Гаджиева Р.М., Бидалов Б.А., Исмаилов А.М., Шомахов З.В. Зависимость морфологии поверхности и структуры пленок $CuIn_{0.95}Ga_{0.05}Se_2$ от температуры селенизации. Т. 24, № 2, с. 107–117.

Неустроев С.А., Неустроев Н.С. Образование ковалентных связей между центральными атомами базовых плоскостей сопряженных призм кубического углерода под воздействием внешнего давления. Т. 24, № 4, с. 342–349.

Тихонов Р.Д., Поломошнов С.А., Костюк Д.В. Спектрофотометрический контроль хлоридного электролита для электрохимического осаждения пермаллоя. Т. 24, № 2, с. 129–136.

Технологические процессы и маршруты

Белов А.Н., Голишников А.А., Костюков Д.А., Шевяков В.И. Металлизация высокотемпературных кремниевых ИС на основе сплава вольфрама с титаном. Т. 24, № 1, с. 22–29.

Громов Д.Г., Дубков С.В., Ерицын Г.С., Савицкий А.И., Быков В.А., Бобров Ю.А. Термическая стабилизация геометрических параметров массива наночастиц серебра, полученного вакуум-термическим испарением на ненагретую подложку. Т. 24, № 6, с. 557–564.

Евдокимова Н.Л., Долгов В.В., Иванов К.А. Определение теплового сопротивления кристалл – корпус полупроводникового прибора из его кривой охлаждения. Т. 24, № 1, с. 30–41.

Каракеев В.И., Рябышенков А.С., Гундарцев М.А. Эксергетический анализ системы воздухообмена в чистых помещениях. Т. 24, № 6, с. 573–580.

Любимов А.В., Борисов А.Г., Корчагин Е.П., Козлитин А.И., Осипенкова Н.Г. Исследование процесса электроосаждения сплава олово – свинец с высоким содержанием свинца. Т. 24, № 5, с. 459–468.

Печерская Е.А., Голубков П.Е., Карпанин О.В., Артамонов Д.В., Сифронов М.И., Печерский А.В. Исследование влияния технологических параметров процесса микродугового оксидирования на свойства оксидных покрытий. Т. 24, № 4, с. 363–369.

Поголов А.И., Титов А.Ю., Тимошенков С.П. Термомеханическая прочность соединений элементов в микроэлектронных модулях. Т. 24, № 6, с. 565–572.

- Полунина А.А., Петров В.С., Ханбеков И.Ф., Ли И.П., Гайдар А.И., Локтев Д.Н.* Термическое активирование геттеров в технологии производства магнетронов. Т. 24, № 4, с. 370–382.
- Рудаков Г.А., Парамонов В.В.* Применение метода комплексного планирования эксперимента для оптимизации процесса глубокого анизотропного плазменного травления кремния. Т. 24, № 4, с. 350–362.
- Сивченко А.С., Кузнецов Е.В., Сауров А.Н.* Определение времени наработки до отказа подзатворного диэлектрика суб-100-нм МОП-транзисторов с помощью ускоренных испытаний. Т. 24, № 5, с. 469–478.
- Тихонов Р.Д., Поломошнов С.А., Амеличев В.В., Костюк Д.В., Черемисинов А.А.* Анализ электрохимического процесса осаждения пленок пермаллоя. Т. 24, № 6, с. 547–556.

Элементы интегральной электроники

- Асаёнок М.А., Зеневич А.О., Новиков Е.В.* Кинетика и амплитуда фотоотклика кремниевых фотоэлектронных умножителей. Т. 24, № 4, с. 391–397.
- Гуминов Н.В., Мьо Мин Тхант, Романок В.А., Шомахмадов Д.П.* Сравнение характеристик GaAs и GaN HEMT-транзисторов. Т. 24, № 1, с. 42–50.
- Кожеевников В.С., Матюшкин И.В., Черняев Н.В., Жукова Т.Д.* Взаимосвязь физической и информационной энтропий в теории надежности для наноразмерных элементов. Т. 24, № 6, с. 589–600.
- Королёв М.А., Мордкович В.Н., Леонов А.В., Девликанова С.С.* Исследование КНИ полевых датчиков Холла в режиме неполного обеднения. Т. 24, № 4, с. 383–390.
- Кулакова А.А., Лукьяненко Е.Б.* Энергоэффективные КМОП-триггеры с инверторной запоминающей ячейкой. Т. 24, № 3, с. 230–238.
- Маковская Т.И., Данилюк А.Л., Кривошеева А.В., Шапошников В.Л., Борисенко В.Е.* Зарядовые свойства транзисторной МОП-структуры с каналом из двумерного кристалла. Т. 24, № 2, с. 137–150.
- Новиков С.Г., Беринцев А.В., Алексеев А.С., Сомов А.И., Светухин В.В.* Исследование влияния температуры на выходные параметры радионуклидных источников электрического питания на основе двойного преобразования энергии радиационного распада. Т. 24, № 2, с. 151–159.
- Озеркин Д.В., Бабешко В.В.* Синтез SPICE-модели МОП-реле 249КП4АТ с учетом температурной зависимости параметров. Т. 24, № 2, с. 185–196.
- Павлова М.Д., Дегтерев А.Э., Ламкин И.А., Тарасов С.А.* Влияние параметров процесса формирования нанокompозитного слоя «фталоцианин:фуллерен» на фотоэлектрические характеристики структур ZnPc:C₆₀/C₆₀. Т. 24, № 4, с. 398–406.
- Петросяни К.О., Исмаил-Заде М.Р., Самбурский Л.М.* Особенности моделирования ВАХ JFET-транзисторов в диапазоне криогенных температур. Т. 24, № 2, с. 174–184.
- Рязанцев Д.В., Кузнецов Е.В.* Локальный нагрев интегрального МОП-дозиметра для отжига накопленного заряда. Т. 24, № 6, с. 581–588.
- Семёнов А.А., Усанов Д.А., Дронкин А.С.* Активный аппаратный стек процессора. Т. 24, № 3, с. 219–229.
- Сергеев В.А., Смирнов В.И., Ходаков А.М., Куликов А.А., Черняков А.Е.* Влияние дефектов структуры и конструкции на тепловые характеристики мощных биполярных СВЧ-транзисторов. Т. 24, № 5, с. 479–488.
- Юсипова Ю.А.* Динамика вектора намагниченности свободного слоя спин-вентильной структуры в магнитном поле, перпендикулярном плоскости слоев. Т. 24, № 5, с. 489–502.
- Юсипова Ю.А.* Прецессия намагниченности свободного слоя спинового вентиля и его переключение при воздействии магнитного поля, перпендикулярного оси анизотропии. Т. 24, № 2, с. 160–173.
- Якунин А.Н., Аунг Мьо Сан.* Исследование и модификация многоразрядного параллельно-префиксного сумматора. Т. 24, № 2, с. 197–207.

Схемотехника и проектирование

- Melikyan V.Sh., Hayrapetyan A.K., Kostanyan H.T., Margaryan H.V., Grigoryan H.T., Martirosyan A.A.* Power Supply Ratio Improvement Using Self-Calibration in Voltage Regulators (*Меликян В.Ш., Айрапетян А.К., Костанян А.Т., Маргарян А.В., Григорян А.Т., Мартиросян А.А.* Улучшение коэффициента подавления нестабильности питания с помощью самокалибровки в регуляторах напряжения). Т. 24, № 3, с. 248–256.
- Melikyan V.Sh., Khachikyan K.T., Gumroyan H.V., Babayan A.V., Avushyan S.A., Hakobyan K.T.* Crystal Area Reduction Method for Impedance Matching Systems in High-Speed Data Links (*Меликян В.Ш., Хачикян К.Т., Гумроян Р.В., Бабалян А.В., Авушян С.А., Аконян К.Т.* Метод уменьшения площади кристалла для систем согласования импедансов в высокоскоростных каналах передач). Т. 24, № 5, с. 503–510.
- Кузьминов И.В., Лосев В.В., Новожилов И.С., Чаплыгин Ю.А.* Алгоритм компрессии и декомпрессии потока конфигурационных данных ПЛИС. Т. 24, № 6, с. 610–618.
- Кулакова А.А., Лукьяненко Е.Б.* Блочный метод синтеза триггерных схем с использованием карт минтермов. Т. 24, № 6, с. 601–609.
- Рябцев В.Г., Волобуев С.В.* Имплементация памяти в систему на кристалле со встроенными средствами самотестирования и самовосстановления. Т. 24, № 3, с. 239–247.

Микро- и наносистемная техника

- Аунг Тхура, Симонов Б.М., Тимошенков А.С.* Исследование стойкости МЭМС-акселерометров емкостного типа к внешним механическим воздействиям. Т. 24, № 6, с. 619–626.
- Аунг Тхура, Симонов Б.М., Тимошенков С.П.* Исследование воздействия случайной вибрации на характеристики микромеханических акселерометров. Т. 24, № 5, с. 511–520.
- Ван Хао Ло, Нестеренко Т.Г.* Система резонансной настройки вибрационного многокомпонентного МЭМС-гироскопа. Т. 24, № 3, с. 267–278.
- Губанова О.В., Кузнецов Е.В., Рыбачек Е.Н., Сауров А.Н.* Биосенсор на основе химически чувствительного нанопроволочного полевого транзистора с минимальным контактом к плавающему затвору. Т. 24, № 4, с. 407–414.
- Йе Ко Ко Аунг, Аунг Тхура, Симонов Б.М., Тимошенков С.П.* Параметры чувствительного элемента сэндвич-конструкции емкостного микромеханического акселерометра. Т. 24, № 3, с. 257–266.

Информационно-коммуникационные технологии

- Виноградов А.Н.* Модель системы управления движением мобильного робота на основе нечеткой логики. Т. 24, № 1, с. 79–86.
- Воротинёв Д.В., Голованов Р.В.* Методика обучения бинарных классификаторов в задачах сегментации изображений. Т. 24, № 3, с. 279–290.
- Гагарина Л.Г., Гайдук И.О., Кремер Е.А., Можжухина А.В.* Эффективный метод локализации ошибок при проектировании специализированных БИС. Т. 24, № 5, с. 530–538.
- Ермошенко Ю.М.* Модель вектора состояния в виде квазислучайного процесса для комплексного аэрологического радиозондирования атмосферы. Т. 24, № 1, с. 72–78.
- Кобяк И.П.* Идентификация бернуллиевских последовательностей криптографическими методами. Т. 24, № 3, с. 301–308.
- Матюшкин И.В., Заплетина М.А.* Отражение и транспонирование данных в матрице клеточно-автоматного вычислителя. Т. 24, № 1, с. 51–63.
- Минаков Е.И., Валихин Г.А.* Определение потерь распространения радиолокационной волны вблизи земной поверхности. Т. 24, № 1, с. 64–71.

Минаков Е.И., Мешков А.В., Мешкова Е.О. Модифицированное преобразование Хафа в задаче повышения вероятности обнаружения объектов в радиоэлектронных системах наблюдения. Т. 24, № 3, с. 291–300.

Петров Е.Н., Гагарина Л.Г. Разработка программного модуля динамического управления вводом-выводом библиографических данных. Т. 24, № 4, с. 415–422.

Севрюкова Е.А., Волкова Е.А., Угроватов А.В., Копылова М.Д. Имитационное моделирование системы мониторинга окружающей среды. Т. 24, № 5, с. 521–529.

Краткие сообщения

Гончаров И.Н., Козырев Е.Н., Урумов В.В. Оптимизация усилительной способности двухкамерных электронно-оптических преобразователей. Т. 24, № 4, с. 428–432.

Гуляев А.С., Кольцов В.Б., Севрюкова Е.А. Применение программных средств для оценки термодинамической устойчивости на примере железа. Т. 24, № 3, с. 309–312.

Ключников А.С., Красюков А.Ю., Артамонова Е.А., Королёв М.А., Ефимова Д.И. Влияние толщины пленки кремния КНИ-структуры на параметры планарного беспереходного МОП-транзистора. Т. 24, № 1, с. 87–91.

Лупин С.С. Имитационная модель для оценки эффективности процессов сбора и переработки промышленных отходов. Т. 24, № 4, с. 423–427.

Сергеев В.А., Фролов И.В., Радаев О.А. Связь уровня фототока светоизлучающих InGaN/GaN-гетероструктур с уровнем НЧ-шума и порогового тока. Т. 24, № 1, с. 92–96.

Юбилей

Гаврилову Сергею Витальевичу – 60 лет. Т. 24, № 6, с. 628.

Грибов Б.Г., Горнев Е.С., Плотицкий Ю.И., Тельминов О.А. Научно-исследовательский институт молекулярной электроники: от выполнения НИОКР к электронным технологиям мирового уровня. Т. 24, № 3, с. 317–321.

Лабунову Владимиру Архиповичу – 80 лет. Т. 24, № 2, с. 210–211.

Петросянцу Константину Орестовичу – 75 лет. Т. 24, № 2, с. 212.

Конференции

3rd International Conference on Microelectronic Devices and Technologies (MicDAT'2020), 17–19 June 2020, Tenerife (Canary Islands), Spain. Т. 24, № 6, 2-я стр. обложки.

26-я Всероссийская межвузовская научно-техническая конференция студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика – 2019». Т. 24, № 1, 4-я стр. обложки.

Об итогах 26-й Всероссийской межвузовской научно-технической конференции студентов и аспирантов «Микроэлектроника и информатика – 2019». Т. 24, № 3, с. 322.

Об итогах 2-й Международной конференции «Микроэлектронные приборы и технологии» (MicDAT' 2019), 22–24 мая 2019 г., г. Амстердам, Голландия. Т. 24, № 6, с. 629–630.

Объединенная выставка ЭлектронТехЭкспо и ЭкспоЭлектроника. Т. 24, № 1, 3-я стр. обложки.

Открытие Центра компетенций национальной технологической инициативы «Сенсорика» в МИЭТ. Т. 24, № 1, с. 97–98.

От Российской академии наук. Т. 24, № 6, с. 627.

Памяти Бархоткина Вячеслава Александровича. Т. 24, № 3, с. 313–314.

Памяти Жореса Ивановича Алфёрова. Т. 24, № 2, с. 208–209.

Памяти Усанова Дмитрия Александровича. Т. 24, № 3, с. 315–316.